产品概览

FGH75T65UPD: 650V, 75A，场截止沟道IGBT

欲看完整文档，请参阅数据表。

飞兆半导体的新型场截止沟道 IGBT 系列产品采用创新型场截止沟道 IGBT 技术，为光伏逆变器、UPS、焊机和数字功率产生器等低导通和开关损耗至关重要的应用提供了最佳性能。

特性

- 最大结温：TJ = 175°C
- 正温度系数，适合并联运行
- 高电流能力
- 低饱和电压：VCE(sat) = 1.65V（典型值）@ IC = 75A
- 高输入阻抗
- 紧密的参数分布
- 符合 RoHS 标准
- 短路耐用性：25°C 时为 5μs

应用

- Uninterruptible Power Supply
- Energy Generation & Distribution

欲了解更多信息，请联系您当地的销售支援 www.onsemi.cn 。
创建于：7/21/2019